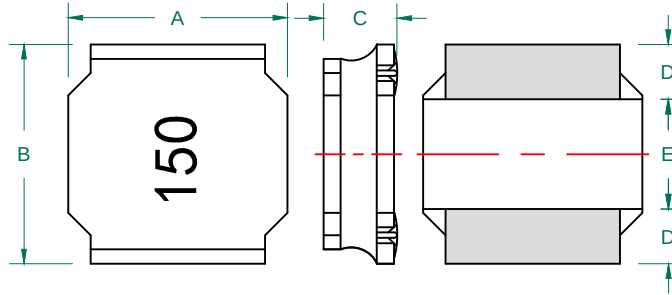


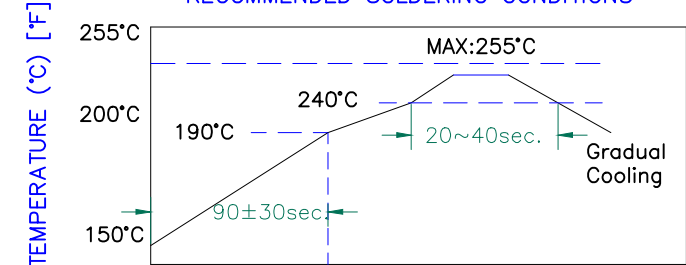
TYS4020150M-10

PHYSICAL DIMENSIONS:

A	4.00	± 0.20
B	4.00	± 0.20
C	2.00	MAX.
D	0.95	± 0.20
E	2.10	± 0.20



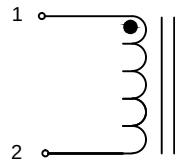
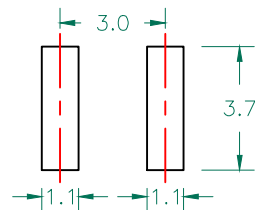
RECOMMENDED SOLDERING CONDITIONS



ELECTRICAL SPECIFICATION

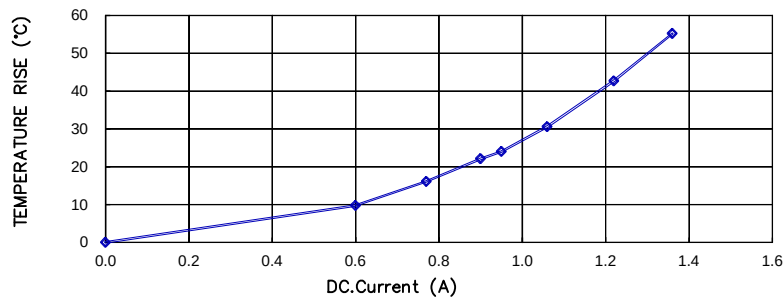
	Min	Nom	Max
INDUCTANCE (uH) L @ 100 KHz/1V ± 20%	12.0	15.0	18.0
DCR (Ω)		0.230	0.299

Saturation Current(A)	1.35
SRF (MHz)	24
Temperature Rise Current (A)	0.77

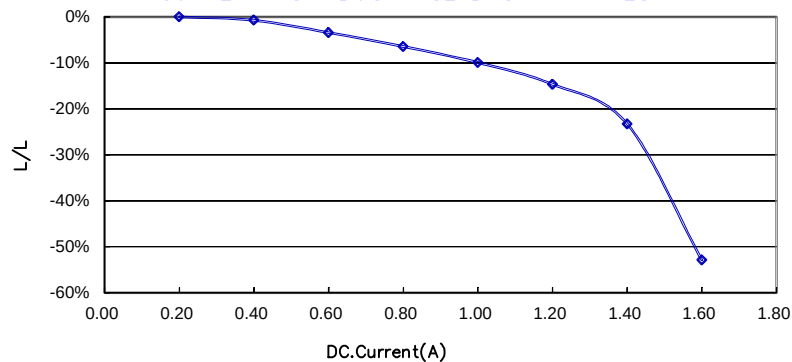


RoHS

CHARACTERISTICS OF TEMPERATURE RISE



CURRENT VS INDUCTANCE DROP IN RATES



UNCONTROLLED DOCUMENT

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

1. OPERATING TEMPERATURE RANGE: -40°C TO +125°C (INCLUDING SELF-HEATING) .
2. STORAGE TEMPERATURE RANGE (PACKAGING CONDITIONS): -10°C TO +40°C AND RH 70% (MAX.)
3. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, THE STANDARD ATMOSPHERIC CONDITIONS FOR MEASUREMENT/TEST AS:
A. AMBIENT TEMPERATURE: 20±15°C.
B. RELATIVE HUMIDITY: 65%±20%.
4. DEFINITION OF SATURATION CURRENT (ISAT): DC CURRENT AT WHICH THE INDUCTANCE DROPS ≤30% FROM ITS VALUE WITHOUT CURRENT.
5. DEFINITION OF TEMPERATURE RISE CURRENT (IRMS): DC CURRENT THAT CAUSES THE TEMPERATURE RISE (ΔT ≤40°C) FROM 20°C AMBIENT.

DIMENSIONS ARE IN mm .				This print is the property of Laird Tech. and is loaned in confidence subject to return upon request and with the understanding that no copies shall be made without the written consent of Laird Tech. All rights to design or invention are reserved.			
				PROJECT/PART NUMBER:	REV	PART TYPE:	DRAWN BY:
				TYS4020150M-10	B	POWER INDUCTOR	QIU
B	CHANGE LOGO	08/06/15	QIU	DATE:	09/06/12	SCALE:	NTS
A	ORIGINAL DRAFT	09/06/12	QIU	CAD #		TOOL #	
REV	DESCRIPTION	DATE	INT	TYS4020150M-10-B			
							1 of 1

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А